

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2005年1月6日 (06.01.2005)

PCT

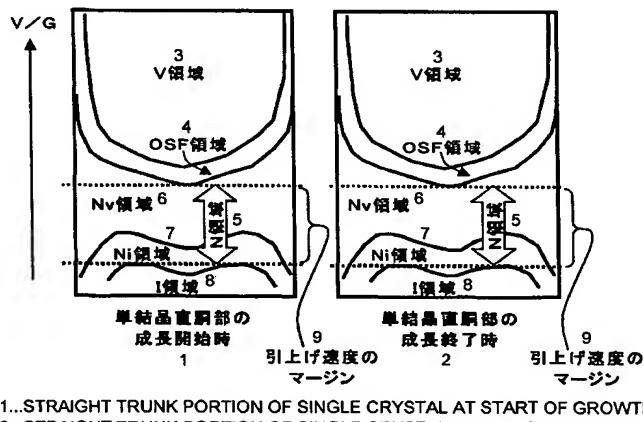
(10) 国際公開番号
WO 2005/001169 A1

(51) 国際特許分類 ⁷ :	C30B 15/20, 29/06	(72) 発明者; および
(21) 国際出願番号:	PCT/JP2004/007252	(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 三田村 伸晃 (MITAMURA, Nobuaki) [JP/JP]; 〒9618061 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字大平 150 番地 信越半導体株式会社 半導体白河研究所内 Fukushima (JP). 太田 友彦 (OHTA, Tomohiko) [JP/JP]; 〒3790125 群馬県安中市中野谷字松原 507 信越半導体株式会社 横野平工場内 Gunma (JP). 布施川 泉 (FUSEGAWA, Izumi) [JP/JP]; 〒9618061 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字大平 150 番地 信越半導体株式会社 半導体白河研究所内 Fukushima (JP). 櫻田 昌弘 (SAKURADA, Masahiro) [JP/JP]; 〒9618061 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字大平 150 番地 信越半導体株式会社 半導体白河研究所内 Fukushima (JP). 尾崎 篤志 (OZAKI, Atsushi) [JP/JP]; 〒9618061 福島県西白河郡西郷村大
(22) 国際出願日:	2004年5月27日 (27.05.2004)	
(25) 国際出願の言語:	日本語	
(26) 国際公開の言語:	日本語	
(30) 優先権データ:	特願2003-184838 2003年6月27日 (27.06.2003) JP	
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 信越半導体株式会社 (SHIN-ETSU HANDOTAI CO.,LTD.) [JP/JP]; 〒1000005 東京都千代田区丸の内1丁目4番2号 Tokyo (JP).		

[続葉有]

(54) Title: METHOD FOR PRODUCING SINGLE CRYSTAL AND SINGLE CRYSTAL

(54) 発明の名称: 単結晶の製造方法及び単結晶



1...STRAIGHT TRUNK PORTION OF SINGLE CRYSTAL AT START OF GROWTH
 2...STRAIGHT TRUNK PORTION OF SINGLE CRYSTAL AT END OF GROWTH
 3...V REGION
 4...OSF REGION
 5...N REGION
 6...Nv REGION
 7...Ni REGION
 8...I REGION
 9...MARGIN OF PULL-UP RATE

WO 2005/001169 A1

(57) Abstract: A method for producing a single crystal having a whole face in the radius direction being free of a defect through the pull-up of the single crystal from a melt of a raw material in a chamber by the Czochralsky Method, characterized in that conditions for the pull-up in the growth direction are changed so that the margin of the pull-up rate allowing the formation of a whole face in the radius direction free of a defect takes a specific value or more. The method can be employed for stably producing a single crystal having a whole face in the radius direction being free of a defect, over the whole region in the direction of the growth axis of the crystal, in the growth of a single crystal by the CZ method.

(57) 要約: 本発明は、チョクラルスキー法によりチャンバ内で単結晶を原料融液から引上げて径方向の全面が無欠陥領域となる単結晶を製造する方法において、前記単結晶をその径方向の全面が無欠陥領域となるように引上げることのできる引上げ速度のマージンが常に所定

[続葉有]



字小田倉字大平150番地 信越半導体株式会社 半導体白河研究所内 Fukushima (JP).

(74) 代理人: 好宮 幹夫 (YOSHIMIYA, Mikio); 〒1110041 東京都台東区元浅草2丁目6番4号 上野三生ビル 4F Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイドスノート」を参照。